

**(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG**

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
19. Februar 2004 (19.02.2004)

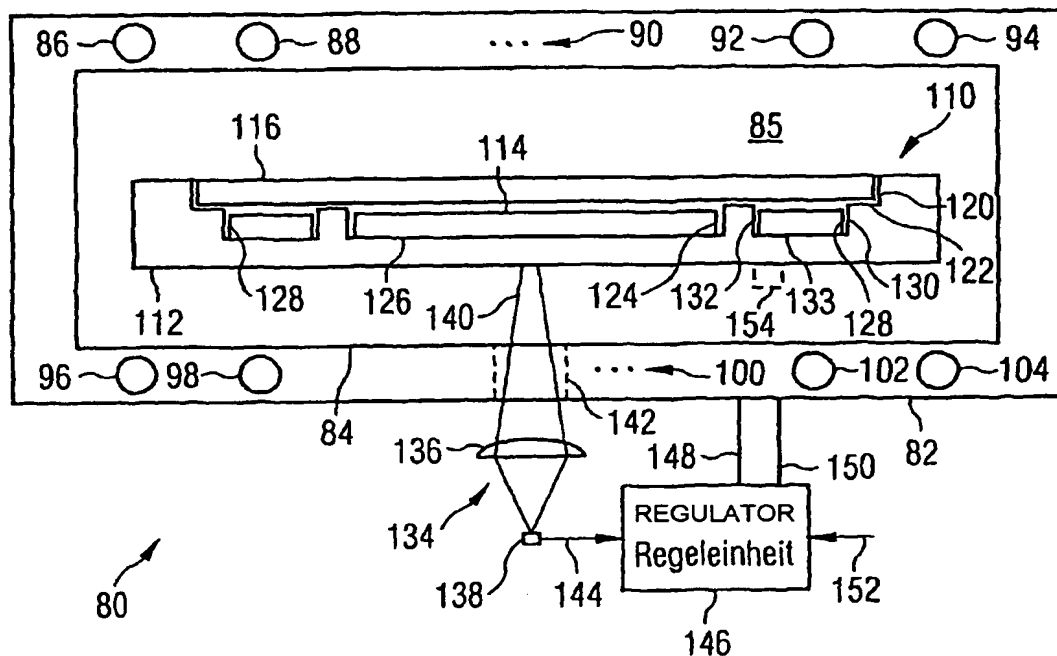
(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2004/015754 A3

- | | |
|---|--|
| <p>(51) Internationale Patentklassifikation⁷: H01L 21/316, 21/321, 21/762, 21/322, 21/32, 21/763</p> <p>(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE2003/002523</p> <p>(22) Internationales Anmeldedatum: 26. Juli 2003 (26.07.2003)</p> <p>(25) Einreichungssprache: Deutsch</p> <p>(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch</p> <p>(30) Angaben zur Priorität: 102 34 694.1 30. Juli 2002 (30.07.2002) DE</p> <p>(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): INFINEON TECHNOLOGIES AG [DE/DE]; St. Martin-Strasse 53, 81669 München (DE).</p> | <p>(72) Erfinder; und</p> <p>(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): CHUNG, Hin-Yiu [DE/DE]; Daimlerstrasse 10, 89160 Dornstadt (DE). GUTT, Thomas [DE/DE]; Truderinger Strasse 2, 82008 Unterhaching (DE).</p> <p>(74) Anwalt: KARL, Frank; Patentanwälte Kindermann, Postfach 1330, 85627 Grasbrunn (DE).</p> <p>(81) Bestimmungsstaaten (national): CN, JP, KR, SG, US.</p> <p>(84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).</p> <p>Veröffentlicht:
— mit internationalem Recherchenbericht</p> <p>(88) Veröffentlichungsdatum des internationalen Recherchenberichts: 21. Mai 2004</p> |
|---|--|

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: METHOD FOR OXIDATION OF A LAYER AND CORRESPONDING HOLDER DEVICE FOR A SUBSTRATE

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUM OXIDIEREN EINER SCHICHT UND ZUGEHÖRIGE AUFNAHMEVORRICHTUNGEN FÜR EIN SUBSTRAT



(57) Abstract: Amongst other things a method is disclosed, whereby a layer for oxidation is preferably processed in a single substrate process, whereby the process temperature during the processing is recorded directly on the substrate or on a holder device (110) for the substrate. Oxide layers with precisely fixed oxide widths can be generated.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

WO 2004/015754 A3

In1243TW

Abstract

Method for oxidizing a layer, and associated holding devices for a substrate

The invention explains, inter alia, a method in which a layer which is to be oxidized is processed, preferably in a single-substrate process, the process temperature during the processing being recorded directly at the substrate (114) or at a holding device (110) for the substrate. It is possible to produce oxide layers with an accurately predetermined oxide width.

(Figure 3)